

FEATURES

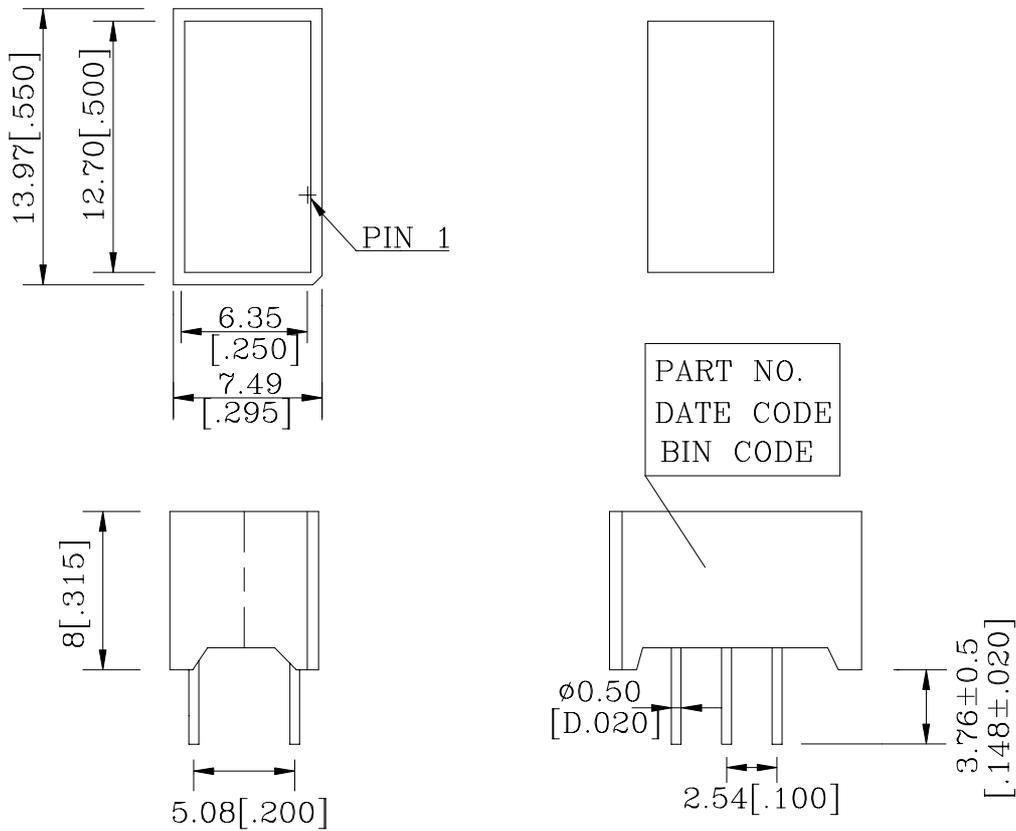
- * RECTANGULAR LIGHT BAR.
- * LARGE, BRIGHT, UNIFORM LIGHT EMITTING AREAS.
- * LOW POWER REQUIREMENT.
- * HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST.
- * SOLID STATE RELIABILITY.
- * CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.

DESCRIPTION

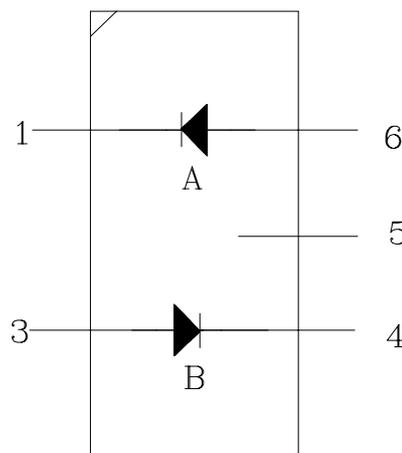
The LTL-57173HR is a light bar rectangular light sources designed for a variety of applications where a large bright source of light is required. This device utilizes high efficiency red LED chips, which are made from GaAsP on a transparent GaP substrate, and has red bar.

DEVICE

PART NO.	DESCRIPTION
Hi-Eff. Red	Universal
LTL-57173HR	Rectangular Bar

PACKAGE DIMENSIONS

NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25 mm (0.01") unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	CATHODE A
2	NO PIN
3	ANODE B
4	CATHODE B
5	NO CONNECTION
6	ANODE A

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	75	mW
Peak Forward Current Per Segment (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	100	mA
Continuous Forward Current Per Segment Derating Linear From 25°C Per Segment	25 0.33	mA mA/°C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35°C to +85°C	
Storage Temperature Range	-35°C to +85°C	
Solder Temperature: max 260°C for max 3sec at 1.6mm below seating plane.		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I _v	2360	4200		μcd	I _F =10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		635		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		40		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		623		nm	I _F =20mA
Forward Voltage Per Segment	V _F		2	2.6	V	I _F =20mA
Reverse Current Per Segment	I _R			100	μA	V _R =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _v -m			2:1		I _F =10mA

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

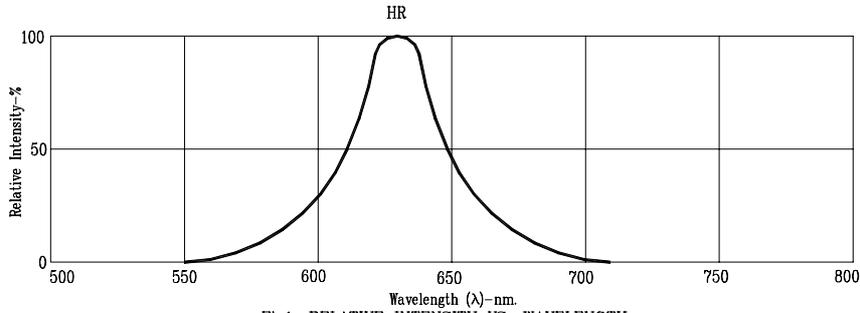


Fig1. RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

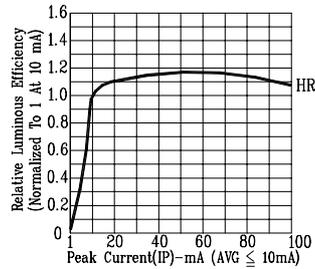


Fig2. RELATIVE LUMINOUS EFFICIENCY (LUMINOUS INTENSITY PER UNIT CURRENT) VS. PEAK CURRENT (REFRESH RATE 1KHz)

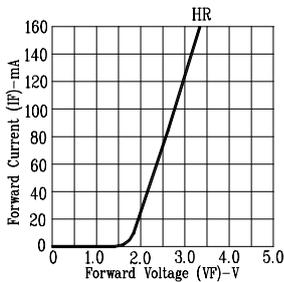


Fig3. FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

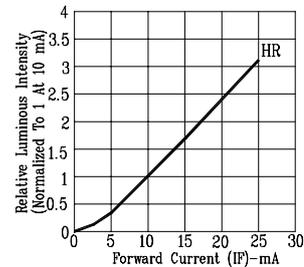


Fig4. RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

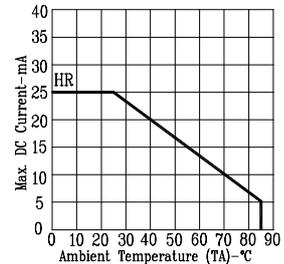


Fig5. MAX. ALLOWABLE DC CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE.

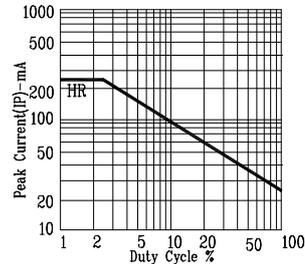


Fig6. MAX. PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE 1KHz)

NOTE: HR=HL - EFF. RED

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9